



## **Toshiba présente des commutateurs multiplexeurs 2:1/démultiplexeurs 1:2 de 32 Gbit/s pour les signaux à grande vitesse**

*Les commutateurs à 1 voie / 2 voies à canal différentiel prennent en charge les interfaces PCIe® 5,0, USB4® et Thunderbolt™ 4 pour la connexion et l'extension des périphériques dans les PC, les équipements de serveur et les appareils mobiles.*

**Düsseldorf, Allemagne, 24 septembre 2024** – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») a lancé deux nouveaux commutateurs multiplexeur/démultiplexeur (Mux/De-Mux) de canaux différentiels à haute vitesse, les TDS4A212MX et TDS4B212MX, conçus pour des vitesses de signalisation allant jusqu'à 32Gbps. Logés dans un boîtier compact, ces dispositifs prennent en charge PCIe® 5,0, USB4® Ver.2, Thunderbolt™ 4 et DisplayPort™ 2,0 pour connecter et étendre les périphériques dans des applications telles que les PC, les équipements de serveur, les appareils mobiles, etc.

Ces deux nouveaux produits offrent une bande passante à -3 dB (différentielle) de 26,2 GHz ou 27,5 GHz (typ.) pour un courant continu maximal en mode actif de 150 µA, garantissant des niveaux élevés d'intégrité du signal. Toshiba obtient ces caractéristiques de haute performance en adoptant sa technologie propriétaire de traitement frontal à SOI-CMOS (*silicon-on-insulator complementary metal oxide semiconductor*), appelée TaRFSOI™.

La plage de fonctionnement du signal différentiel est de 0 à 2,0 V pour la tension en mode commun et de 0 à 1,8 V<sub>pp</sub> pour la tension différentielle, ce qui permet de prendre en charge une large gamme de normes d'interface différentielle. En mode veille, la consommation en courant peut être réduite à 10 µA, voire moins, pour économiser l'énergie. Les nouveaux dispositifs peuvent fonctionner à des températures ambiantes comprises entre - 40 °C et + 85 °C.

Logés dans un minuscule boîtier XQFN16 de 2,4 mm x 1,6 mm avec un profil de 0,4 mm, les deux composants répondent aux besoins des ingénieurs qui cherchent à minimiser l'occupation d'espace sur le circuit imprimé. Le TDS4B212MX possède un brochage

optimisé pour obtenir des performances à haute fréquence, tandis que le brochage du TDS4A212MX facilite l'agencement du circuit imprimé.

Outre ces deux nouveaux dispositifs haute performance pour USB4<sup>®</sup>, PCIe<sup>®</sup> Gen 4 et Thunderbolt™ 4, Toshiba a également élargi la gamme disponible chez Farnell pour d'autres commutateurs de bus à grande vitesse. Ceux-ci conviendraient pour USB<sup>®</sup> 2,0, PCIe<sup>®</sup> Gen 1, ainsi que pour les entrées/sorties à usage général (GPIO) en 5 V et basse tension, avec des dispositifs de décalage de niveau pour les interfaces de type I<sup>2</sup>C. Les ingénieurs concepteurs disposent ainsi d'un large choix de commutateurs de bus et d'options de décalage de niveau.

Lisez-en plus sur les commutateurs multiplexeur/démultiplexeur TDS4A212MX et TDS4B212MX sur le site web de Toshiba :

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TDS4A212MX.html>

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TDS4B212MX.html>

Les livraisons des deux nouveaux composants commencent aujourd'hui.

###

#### À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (*hard disk drive*, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres.

En outre, TEE propose également les cellules et modules de batterie SCiB™ de Toshiba à l'oxyde de lithium-titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes et les substrats céramiques en nitrure de silicium (SiN) utilisés dans les modules semi-conducteurs de puissance, les onduleurs et les convertisseurs pour leurs caractéristiques de dissipation thermique et leur résistance.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com), [www.scib.jp/en](http://www.scib.jp/en) et [www.toshiba-tmat.co.jp/en/](http://www.toshiba-tmat.co.jp/en/) pour plus d'informations sur la société et ses produits.

#### Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0

Web : [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

#### Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)7464 493526

E-mail : [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Publié par:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +49 (0) 4181 968098-13

Web : [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail : [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

**Septembre 2024**

**Ref. 7558F**